

2026 年 9 月 吉日

御 得 意 様 各 位

第 3 回【九州】半導体産業展出展のご案内

拝啓

時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。また、平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
弊社はこのたび「第 3 回【九州】半導体産業展」にて、実績豊富な電子部品用および
半導体パッケージングプロセス用表面処理技術に加え、新たな技術および新規製品を多数出展いたします。
是非ご来場賜り、弊社出展品をご高覧頂きたくご案内申し上げます。

敬具

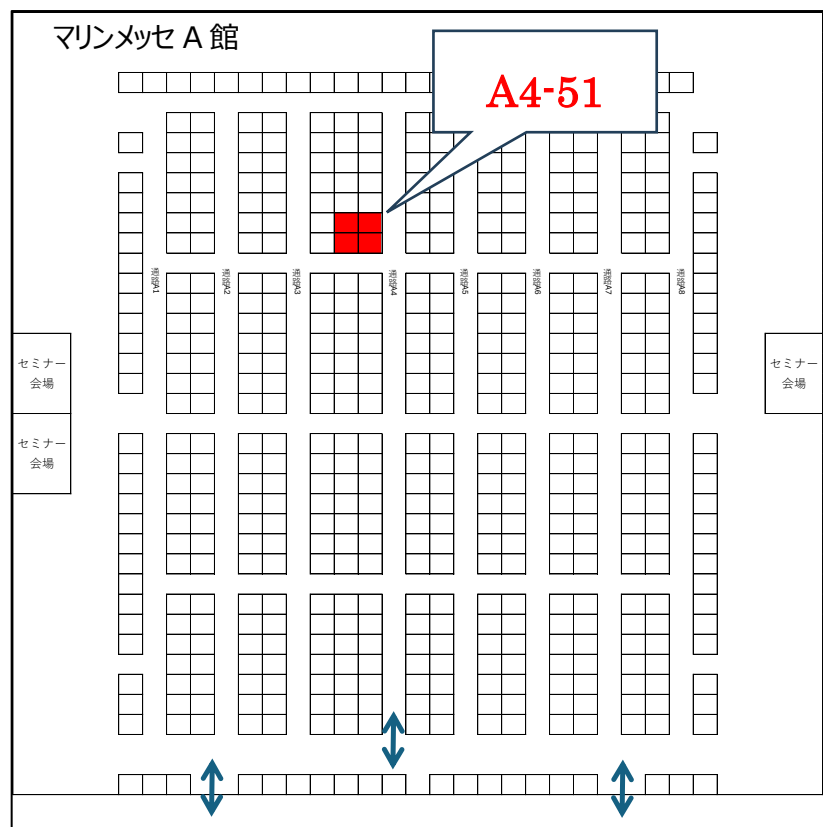
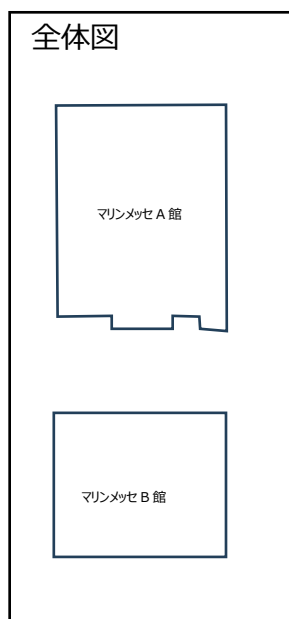
記

日 時：2026 年 9 月 30 日(水)～ 10 月 1 日(木)

開場時間：10：00～17：00

会 場：マリンメッセ福岡 A・B 館

小間位置：マリンメッセ福岡 A 館 A4-51



【展示品】

□銅バンプに直接すず合金めっきが可能。異種径の同時めっきで生産効率を改善！

銅バンプ形成に最適化された硫酸銅めっき添加剤です。銅上に直接すず合金めっきを可能にし、従来必要であったニッケル工程の削減と工程効率化を実現します。さらに、異なる径のバンプを一度にめっきできるため、生産効率の向上とコスト削減に貢献します。リフロー後においても異種径バンプの高さを均一化し、安定した接続信頼性を確保します。外観品質にも優れ、高い実装信頼性と工程簡略化の両立を実現するソリューションです。

製品名：Melprime CU-8210

□半導体業界で実績 No.1 の無電解 UBM めっきプロセス

半導体業界で豊富な採用実績を持つ無電解 UBM（Under Bump Metallization）めっきプロセスです。Ni/Pd/Au などの多層構造により金属拡散を抑制し、パワー半導体の高温環境下においても優れた接合信頼性を長期にわたり維持します。Al、AlSi、AlCu、AlSiCu といった多様な外部電極に対して高い密着性と均一な被膜形成を実現し、微細パッドにも精密に対応可能です。さらに、薄ウエハにおいても反り・変形を抑制しながら膜厚均一性を確保し、不要部への析出を防ぐ高選択性プロセスを提供します。また、前処理（クリーニング・エッチング・置換反応）から無電解 Ni/Pd/Au めっきまでの一貫したプロセス設計により、安定した UBM 形成を実現。Pb 半田リフロー後においても健全な電極界面を維持し、高い実装信頼性を発揮します。両面冷却パワーモジュールなどの先進パッケージ構造にも対応し、次世代半導体デバイスの高信頼実装を支えるソリューションです。

製品名：Melplate UBM Process

□3つのケミストリーが導く、最適な銅シード層エッチングプロセス設計

本ソリューションは、異なる特性を持つ3種類のケミカルにより、銅シード層エッチングにおける多様なプロセス要求に最適に対応します。用途や条件に応じた最適なプロセス設計を可能にし、生産性・品質の両立に貢献します。高速処理、高選択性、微細配線対応など、それぞれ異なる強みを持つ製品ラインアップにより、配線形成からバンプ形成まで幅広い工程に対応可能です。

製品名：①E-Process WL ②Melstrip CU-3910 ③Melstrip CU-3935

□高選択チタンシード層エッチング剤 — 他金属を侵さず Ti のみを精密除去

チタンシード層を高選択的にエッチングする専用薬剤です。銅、アルミニウム、Sn 合金に対する侵食を極めて低く抑えながら、チタンのみを効率的に除去できるため、微細パターン形成に最適です。過酸化水素を酸化剤としつつ高い安定性を確保しており、処理中およびチタン溶解後においてもエッチング速度が安定します。また、エッチング後のアンダーカットを低減し、形状精度の高い加工を実現します。さらに、フッ素化合物を含有しない処方により、プロセスの安全性・取り扱い性にも配慮した設計となっています。

製品名：Melstrip TI-3991

□バンプダメージ低減・環境配慮型ドライフィルム剥離剤 — 高性能 2 製品ラインアップ

本製品群は、ドライフィルムレジストの高い剥離性能と、バンプおよび微細配線への低ダメージを両立した剥離剤シリーズです。厚膜対応・バンプ保護を重視したタイプと、環境負荷低減・微細配線対応に特化したタイプの2製品をラインアップし、多様なプロセスニーズに対応します。

製品名：①Melstrip DF-3880 ②Melstrip DF-3890